JP4213841

Publication Title:

RESIN CUTTING METHOD AND DEVICE FOR RESIN SEALED SEMICONDUCTOR ELEMENT

Abstract:

PURPOSE:To easily remove the burr of molded resin jutting out of the lead peripheral part of a package by non-contact step within a short time assuming the semiconductor element resin-sealed by a molding step as a target element.

CONSTITUTION: The title resin cutting device is composed of a laser oscillator 4, a light-guiding channel 5 guiding the laser beams 9 emitted from the laser oscillator 4, a condenser 7 fixed to the end of the light-guiding channel and a field stopping mask interposed in the light-guiding channel on the position in front of the condenser 7. Finally, the burred position of a semiconductor element is irradiated with the laser beams emitted from the laser oscillator 4 so as to remove the burr by the processing mechanisms for the steps such as heating, melting down and separating.

Data supplied from the esp@cenet database - http://ep.espacenet.com

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-213841

(43)公開日 平成4年(1992)8月4日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01L 21/56

D 6412-4M

審査請求 未請求 請求項の数3(全 3 頁)

(21)出顧番号

特願平2-401197

(22)出願日

平成2年(1990)12月11日

(71)出願人 000005234

富士電機株式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

(72)発明者 降簱 光男

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

富士電機株式会社内

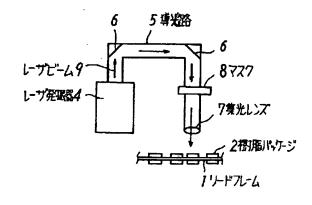
(74)代理人 弁理士 山口 巖

(54) 【発明の名称】 樹脂封止型半導体素子のレジンカツト方法および装置

(57) 【要約】

【目的】モールド成形法で樹脂封止された樹脂封止型半 導体素子を対象に、そのパッケージのリード周辺部分に はみ出した成形樹脂のパリを非接触式,短時間の作業で 簡単に除去する。

【構成】レジンカット装置は、レーザ発振器と、該レーザ発振器から出射したレーザビームを導光する導光路と、該導光路の先端に取付けた集光レンズと、集光レンズの手前位置で導光路に介挿した視野絞り用マスクとからなる。そして、レーザ発振器から出射したレーザビームを半導体素子のパリ発生箇所に照射し、加熱、溶融、蒸発の加工メカニズムによりパリを除去する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】モールド成形法で樹脂封止された樹脂封止 型半導体素子を対象に、そのパッケージのリード周辺部 分にはみ出した成形樹脂のパリを除去するレジンカット 方法であって、パリの生じた部分にレーザビームを照射 してパリを除去することを特徴とする樹脂封止型半導体 素子のレジンカット方法。

【請求項2】請求項1に記載のレジンカット方法におい て、レーザビームの光路上に照射範囲を規制するマスク を置き、該マスクを透過させてレーザビームをパリ部分 10 にのみ選択的に照射することを特徴とする樹脂封止型半 導体素子のレジンカット方法。

【請求項3】レーザ発振器と、該レーザ発振器から出射 したレーザビームを導光する導光路と、該導光路の先端 に取付けた集光レンズと、集光レンズの手前位置で導光 路に介挿した視野絞り用マスクとからなることを特徴と する樹脂封止型半導体素子のレジンカット装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、モールド成形法で樹脂 20 封止された樹脂封止型半導体素子を対象に、そのパッケ ージのリード周辺部分にはみ出した成形樹脂のパリを除 去するレジンカット方法、およびその装置に関する。

[0002]

【従来の技術】頭記した樹脂封止型半導体素子では、樹 脂パッケージのモールド成形の際に成形金型の隙間から 流出した成形材料がリード周辺に付着してパリを生成す る。このパリの発生状況を図3に示すと、図において、 1はリードフレーム、2はリードフレーム1にマウント されたチップ(図示せず)を封止した樹脂パッケージ、 3が樹脂パッケージ2からはみ出した成形樹脂のパリ (斜線で表してある部分) であり、バリ3は樹脂パッケ ージ2から引出したリードの根元周辺部分に付着してい る。

【0003】一方、前記したバリは製品の外観を損うの みならず、リードに半田ディップ、メッキを施す際の障 害となることから、通常は製品の仕上げ工程でパリを除 去するようにしている。この場合のパリ取り方法とし て、従来では研磨剤を使ってバリを除去するバレル方 式、あるいは高圧水を吹付けてバリを除去する高圧水ブ ラスト方式などのレジンカット方法が一般に実施されて いる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、前記した従 来のレジンカット法のうち、パレル方式は研磨剤を使用 するために製品に研磨剤の粉末が付着したり、研磨に伴 って製品の表面にも細かな傷が発生するという難点があ り、特に製品に付着した粉末はパリ取りの後に洗浄する 後処理が必要となる。また、高圧水ブラスト方式では、 高圧水を吹付ける前に薬品を使用してパリを浮かす前処 50 したパリ3の発生箇所に照射される。そして、レーザビ

理が必要である。このように従来のレジンカット法で は、前処理、後処理を含めてバリ取りには多くの手間と 時間がかかる。

【0005】本発明は上記の点にかんがみなされたもの であり、短時間で簡単にバリを除去できるようにした樹 脂封止型半導体素子のレジンカット方法、および装置を 提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明のレジンカット方法は、パリの発生部分にレ ーザピームを照射してパリを除去するものとする。

【0007】ここで、パリ発生箇所以外の製品部分にレ ーザ光が照射されるのを防ぐために、レーザビームの光 路上に照射範囲を規制するマスクを置き、該マスクを透 過させてレーザビームをパリ部分にのみ選択的に照射す るのがよい。

【0008】また、前記方法を実施するための本発明の レジンカット装置は、レーザ発振器と、該レーザ発振器 から出射したレーザビームを導光する導光路と、導光路 の先端に取付けた集光レンズと、集光レンズの手前位置 で導光路に介挿した視野絞り用マスクとから構成するも のとする。

[0009]

【作用】上記のようにバリの発生部分に外部からレーザ ビームを照射することにより、成形樹脂のバリはレーザ による加熱、溶融、蒸発の加工メカニズムで除去され る。また、マスクはレーザビームの照射範囲をパリ発生 部に規制し、それ以外の製品部分にレーザビームが照射 されるのを防ぐように働く。これにより、製品の表面に 付着している成形樹脂のパリを非接触式、かつ短時間で 除去できる。

[0010]

【実施例】以下本発明の実施例を図面に基づいて説明す る。図1はレジンカット装置の構成を示すものであり、 図において、4はレーザ発振器、5はレーザ発振器4か ら引出したレーザビームの導光路、6は導光路5のコー ナ部に設けた反射ミラー、7は導光路5の先端に取付け た集光レンズ、8は集光レンズ7の手前側で導光路5の 途中に介挿した視野絞り用の金属製マスクである。ま た、図2で示すように、前記マスク8には2箇所にレー ザピームの透過穴8a,8bが開口しており、各透過穴 8 a, 8 bがそれぞれ樹脂パッケージ2の両側から引出 したリードフレーム1の根元部に対応している。

【0011】次に前記構成によるレジンカット動作につ いて説明する。まず、レジンカットする半導体素子を集 光レンズ7の真下に来るように位置決めし、ここでレー ザ発振器4を励起するとレーザ発振器4から出射したレ ーザピーム9は導光路5の中を進み、マスク8の透過穴 8 a, 8 bを透過した後に集光レンズ7を経て図3に示 3

ーム9の照射を受けた成形樹脂のパリ3は加熱,溶融,蒸発してリードフレーム1から除去される。なお、マスク8の透過穴8a,8b以外ではレーザビーム9が遮光されるので、パリ発生箇所以外の製品部分、例えば樹脂パッケージ2にレーザビームが照射して不要にスクライブされることはない。なお、図示実施例における光学系の導光路5として光ファイバを採用することも可能である。

[0012]

【発明の効果】以上述べたように本発明のレジンカット 10 方法、および装置においては、樹脂封止型半導体素子の樹脂パッケージからリード周辺にはみ出した成形樹脂のパリに向けてレーザビームを照射するようにしたので、パリを非接触式、かつ短時間のレーザ照射で簡単に除去することができ、従来方式と比べて仕上げ作業の工数削

減、並びに能率の大幅な向上化が図れる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例によるレジンカット装置の構成 図

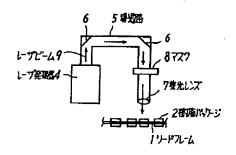
【図2】図1におけるマスクの平面図

【図3】樹脂封止型半導体素子の平面図

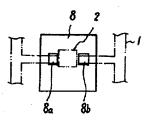
【符号の説明】

- 1 リードフレーム
- 2 樹脂パッケージ
- 3 パリ
- 4 レーザ発振器
- 5 導光路
- 7 集光レンズ
- 8 マスク
- 9 レーザピーム

[図1]



[図2]



【図3】

